

**24.1-18 МОРФОГЕНЕЗ И КИНЕТИКА РОСТА КРИСТАЛЛОВ  $\alpha\text{-TeO}_2$ .** Р.М.Алиев (Азербайджанский Институт Нефти и Химии, Баку), В.И.Пополитов, А.Я.Шапиро (Институт Кристаллографии АН СССР, Москва), СССР.

Структурно-геометрическому анализу подвергнуто свыше 50-ти возможных простых форм  $\alpha\text{-TeO}_2$  (известного также в природе как парателлурит, кристалломорфология которого не изучена). Установленный теоретический морфологический аспект кристаллов проверен специальными экспериментами по гидротермальному их выращиванию в гомогенной области раствора при  $95^{\circ}\text{C}$  и двухфазовой области при  $120\text{-}200^{\circ}\text{C}$  в  $\text{H}_2\text{O}$  водном растворе и изучением кинетики роста граней реальных форм.

Во всех случаях реальный габитус кристаллов определяется экспериментально установленным соотношением  $v_{102} > v_{101} > v_{110}$ , что подтверждает теоретический вывод о доминирующей роли  $\{110\}$  с  $\{100\}$  в равновесной форме кристаллов парателлуритовой структуры и объясняющий полное отсутствие в ней таких форм с простыми индексами как  $\{100\}$  и  $\{001\}$ -появление которых может быть вызвано лишь активным воздействием конкретных факторов среди кристаллизации (изредка наблюдалась слабо развитая  $\{111\}$ ).

При  $120\text{-}200^{\circ}\text{C}$   $v$  граней линейно возрастает с увеличением пересыщения и энергия активации процесса роста составляет 10-13 ккал/моль; следовательно процесс роста происходит в кинетической области.

При  $95^{\circ}\text{C}$   $v_{102} = 3,2 \cdot 10^{-4} \text{ см}^3/\text{s}$  и зависит также от скорости конвекции раствора, что определяется эмпирическим уравнением  $v_{102} = 0,081 W^{0,9}$ . При этой температуре процесс роста лимитируется процессами переноса строительных частиц (растворенной формы  $\text{TeO}_2$ ) к растущему кристаллу.

**24.1-19 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛ И ПОТОКОВ ПРИ РОСТЕ КРИСТАЛЛОВ.** Ю.Смирнов, Калининский государственный университет, г.Калинин, СССР.

Для анализа неизотермических систем при росте кристаллов использовано энтропийное представление взаимосвязей термодинамических сил и потоков (Дьярмати, Неравновесная термодинамика (1974), М., Мир; Смирнов, Редчиц, Физика магнитных материалов, Калинин (1980), 137). Выбор потоков и сил проведен из рассмотрения уравнения Гиббса для локального объема. Теоретическая оценка влияния диполь-дипольного взаимодействия на процесс вытеснения ассоциатов в кристаллическую решетку показала, что градиент потенциала дипольной сетки вносит вклад в массоперенос при росте кристалла как по нормали к поверхности кристалла, так и вдоль поверхности.

Изучено влияние переохлаждения германьевого расплава на скорость роста монокристаллов в интервале скоростей от  $2 \cdot 10^{-5}$  до  $2 \cdot 10^{-4} \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$  (Смирнов, Изв. АН СССР, Сер. физическая (1976) 40, 1344).

Исследована кинетика кристаллизации капель герmania при переохлаждениях от 50 до 230 К. Экспериментальные данные по связи переохлаждения и дислокационной структуры показали влияние на плотность дислокаций переохлаждений, превышающих 8 К.

Формы монокристаллов герmania и парателлурита существенно менялись с переохлаждением от антискелетов и граничных форм до скелетов и дендритов. В результате показаны возможности получения бездислокационных монокристаллов герmania и монокристаллов с большой площадью поперечного сечения (Смирнов, Цветные металлы (1977) 5, 48; Смирнов, Кузнецова, Цветные металлы (1979) 2, 53). Рассмотрены термодинамические силы, вносящие значительный вклад в потоки для четырех процессов выращивания искусственных кристаллов (герmania, парателлурита, граната, интерметаллических соединений) и двух процессов образования природных кристаллов (алмаза и граната).